

## 杭州士兰微电子股份有限公司

### 关于签署《战略合作框架协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 本协议为各方深化合作、围绕项目达成战略合作的总体框架。项目所涉具体合作内容、方案，需经各方完成各自的内部审批流程后，以各方另行签署的投资合作协议等为准。

公司拟与相关主体签署的投资合作协议请详见公司于同日披露的《关于对外投资暨签署〈8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议〉的公告》（公告编号：临 2024-042），该事项尚须获得公司股东大会批准，存在一定的不确定性。

● 本协议的签订不会对公司 2024 年度业绩产生影响。

#### 一、框架协议签订的基本情况

##### （一）协议各方：

- 1、厦门市人民政府（以下简称“甲方1”）
- 2、厦门市海沧区人民政府（以下简称“甲方2”，“甲方1”和“甲方2”合称“甲方”）
- 3、杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）

（二）杭州士兰微电子股份有限公司与厦门市人民政府、厦门市海沧区人民政府本着平等互利、优势互补、共谋发展的原则，经友好协商于 2024 年 5 月 21 日在厦门市签署了《8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目战略合作框架协议》（以下简称“《战略合作框架协议》”）。

（三）公司于 2024 年 5 月 20 日召开的第八届董事会第二十四次会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署〈战略合作框架协议〉的议案》。

## 二、框架合作协议的主要内容

### （一）合作内容

1、集成电路产业是厦门新一代信息技术产业的核心基础产业。为抓住中国集成电路产业发展的战略机遇期，共同打造符合国家集成电路产业发展规划、厦门集成电路产业发展规划纲要的特色工艺芯片企业，深化各方在厦门市海沧区的产业合作，发挥各方在区位、政策、技术、运营、市场、资本和产业生态上的综合优势，各方合作在厦门市海沧区投资建设一条以 SiC-MOSFET 为主要产品的 8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线（以下简称“该项目”）。

2、该项目分两期建设，项目一期投资规模约 70 亿元，二期投资规模约 50 亿元，两期建设完成后，将在厦门市海沧区形成 8 英寸碳化硅功率器件芯片年产 72 万片的生产能力，培育一家符合国家集成电路产业发展规划、开展以第三代半导体功率器件研发、制造和销售为主要业务、具有国际化经营能力的半导体公司。

### （二）项目资源配置

1、乙方将向项目充分导入乙方在特色工艺芯片生产线和先进化合物半导体器件生产线技术、市场、人才、运营等方面的优势，结合厦门政策、区位、产业链、综合环境等优势，为产业链上下游企业提供相关产品、技术支撑与服务。

2、甲方为项目提供包括基础设施配套、建设服务、金融服务、人才服务和员工子女教育等方面的支持，并协助项目落地、验收和持续发展。

3、各方共同落实本协议所涉各项合作。

### （三）其他事项

本协议为各方深化合作、围绕该项目达成战略合作的总体框架。项目所涉具体合作内容、方案，需经各方完成各自的内部审批流程后，以各方另行签署的投资合作协议等为准。

## 三、对上市公司的影响

本协议的签订，有利于充分发挥公司在设计制造一体化模式（IDM）中长期积累的独特优势，进一步完善公司在半导体产业链的布局，持续提升核心竞争力，符合公司长期发展战略规划。

本协议的签订不会对公司 2024 年度业绩产生影响。

#### 四、重大风险提示

本协议为各方深化合作、围绕项目达成战略合作的总体框架。项目所涉具体合作内容、方案，需经各方完成各自的内部审批流程后，以各方另行签署的投资合作协议等为准。

公司拟与相关主体签署的投资合作协议请详见公司于同日披露的《关于对外投资暨签署〈8英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议〉的公告》（公告编号：临 2024-042），该事项尚须获得公司股东大会批准，存在一定的不确定性。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024年5月22日